

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成 19 年 3 月 8 日 (2007.3.8)

【公開番号】特開 2005-154709 (P2005-154709A)

【公開日】平成 17 年 6 月 16 日 (2005.6.16)

【年通号数】公開・登録公報 2005-023

【出願番号】特願 2004-24878 (P2004-24878)

【国際特許分類】

C 0 8 L 65/00 (2006.01)

C 0 8 K 5/18 (2006.01)

H 0 1 L 21/368 (2006.01)

H 0 1 L 29/786 (2006.01)

H 0 1 L 21/336 (2006.01)

H 0 1 L 51/05 (2006.01)

【F I】

C 0 8 L 65/00

C 0 8 K 5/18

H 0 1 L 21/368 L

H 0 1 L 29/78 6 1 8 B

H 0 1 L 29/78 6 1 8 A

H 0 1 L 29/78 6 1 7 T

H 0 1 L 29/28

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 1 月 24 日 (2007.1.24)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 1

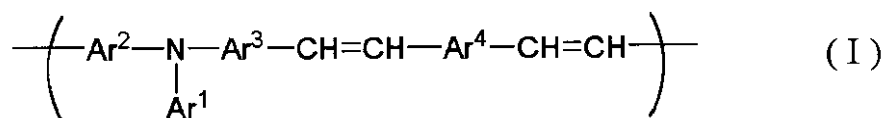
【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1】

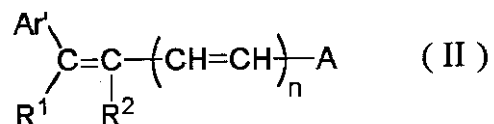
下記一般式 (I) で示される繰り返し単位を有する重合体と、下記一般式 (II) で示される化合物からなる混合物を含有することを特徴とする有機半導体材料。

【化 1】



〔式 (I) 中、Ar¹ は置換もしくは無置換の芳香族炭化水素基を表し、Ar²、Ar³ はそれぞれ独立に置換もしくは無置換の、単環式、非縮合多環式または縮合多環式芳香族炭化水素基の 2 価基を表す。Ar⁴ はベンゼン、チオフエン、ピフェニル、アントラセンの 2 価基を表し、これらは置換基を有していてもよい。〕

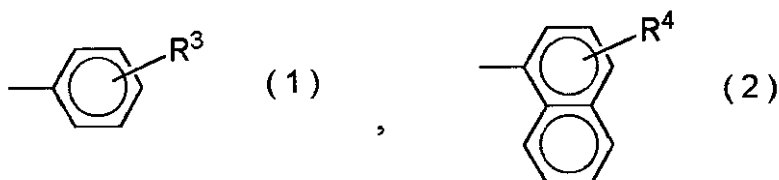
【化 2】



〔式（II）中、 n は0または1の整数、 Ar' は置換もしくは無置換のアリール基を表し、 R^1 は水素原子、置換もしくは無置換のアルキル基あるいは置換もしくは無置換のアリール基を表し、 R^2 は水素原子、置換もしくは無置換のアルキル基あるいは置換もしくは無置換のアリール基を表し、 Ar' と R^1 は共同で環を形成してもよい。

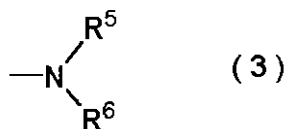
A は下記一般式（1）、（2）で示される基、9-アントリル基または置換もしくは無置換のカルbazolリル基を表す。

【化 3】



式（1）（2）中、 R^3 および R^4 は水素原子、アルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子、又は下記一般式（3）で示される基を表す。

【化 4】



式（3）中、 R^5 および R^6 は置換もしくは無置換のアルキル基、置換または無置換のアリール基を表し、 R^5 および R^6 は同一でも異なってもよく、 R^5 および R^6 は互いに結合して環を形成してもよい。〕

【手続補正 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 1 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1 4】

請求項 1 ~ 10 のいずれかに記載の一般式（I）、（III）、（IV）、（V）、（

VI)、(VII)、(VIII)、(IX)、(X)、又は(XI)で示される繰り返し単位を有する重合体と、請求項1に記載の一般式(II)で示される化合物からなる混合物を含有する有機半導体材料の溶液を塗布した後、溶媒を乾燥させて有機半導体層を形成する工程を含むことを特徴とする有機薄膜トランジスタの製造方法。